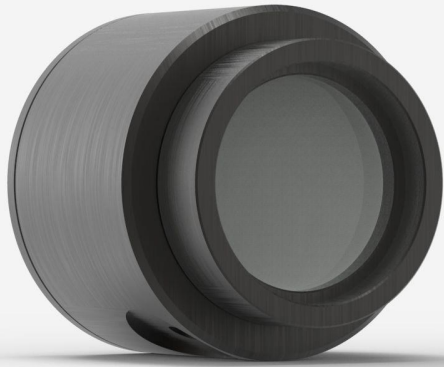


PH100-SI-HA-OD1-D0

Fotodioden-Detektor zur Laserleistungsmessung bis zu 300 mW.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

GROSSE APERTUREN

10 mm Ø für die Siliziumsensoren

3 VERSIONEN

- Silizium 350 - 1080 nm, bis 750 mW
- Silizium-UV 210 - 1080 nm, bis 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, bis 500 mW

WAHL DER ABSCHWÄCHER

HOHE MESSGENAUIGKEIT

Der neue PH100-Si-HA hat eine geringere Kalibrierunsicherheit

PRÄZISE KALIBRIERUNG

Auswahl der Wellenlänge in 1 nm-Schritten

INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Enthält alle Kalibrierungsdaten

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Maximale Durchschnittsleistung ¹	300 mW
Äquivalente Rauschleistung ²	200 pW
Spektralbereich	400 - 1080 nm
Typische Anstiegszeit	0.2 s
Unsicherheit der Leistungskalibrierung ³	±5.0 % (400 - 419 nm) ±4.0 % (420 - 899 nm) ±5.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
Spitzenempfindlichkeit	980 nm
Minimale Wiederholungsrate ⁴	1000 Hz

1. Bei 1064 nm, mit Abschwächer. Siehe Kurven für die maximale Leistung bei anderen Wellenlängen.
2. Bei 980 nm. Nennwert. Der Istwert hängt von der elektromagnetischen Interferenz der Umgebung und der Wellenlänge ab.
3. Mit Abschwächer. Siehe Benutzerhandbuch für die Kalibrierunsicherheit ohne Abschwächer.
4. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte	100 W/cm ²
--	-----------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Apertur-Durchmesser	10 mm
Absorber	Si
Abmessungen	38.1Ø x 36D mm
Gewicht	0,14 kg
Abstand zur Sensorfläche	13,7 mm

BESTELLINFORMATIONEN

PH100-SI-HA-OD1-D0	202683
PH100-SI-HA-OD1-INT-D0	202784
PH100-SI-HA-OD1-IDR-D0	203221

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns